

半导体设备产品对比图

Product model		VF-590Q	VF-570Q	VF-530Q	VF-510Q	VF-300Q	VF-100Q	Model 20Q	Model 206A	S02-12-F	S02-12L-F	S02-30L-F	S02-60-F	VFS-400Q	RLA-120Q	RLA-310Q	RLA-310Q-V	RLA-410Q-V	RLA-420Q-V	VF-530QHLP	VF-530QH	VF-300QHLP	VF-300QH	CLH
晶圆大小	φ300mm	○	○	-	-	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	φ200mm	-	-	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	高达 φ150mm	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	*1	○	○	○	○	○
	600 × 600mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	510 × 515mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	300 × 300mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○
批量大小 (最大存储计数 / 系统)	φ300mm	100	50	-	-	-	25	-	-	100 *2	104 *2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
	φ200mm	-	-	150	150	50	25	125	-	100 *2	-	-	-	-	1	1	1	1	2	100	75	-	50	200
	高达 φ150mm	-	-	200	150	75	50	150	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	100	100	50	75	200
	600 × 600mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 *2	*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	510 × 515mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 *2	*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	300 × 300mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 *2	-	*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他（矩形基板等）	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
*1 需协商 *2 处理片数受基板厚度、翘曲变化。																								
传输系统	晶圆（基板）	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	晶盒储料器	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-
	FOUP 开启器	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FOUP 储料器	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SMIF Pod 开启器	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
系统	立式炉管	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-
	卧式炉管	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	灯退火系统	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
	洁净烘箱系统	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	大口径立式炉管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SiC 功率半导体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
半导体	退火	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	○	-	○	-
	热氧化	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-
	LPCVD (SiN, Poly-Si (Non-Doped, P-Doped) TEOS, HTQ)	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	活化退火	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-
	杂质扩散	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	聚酰亚胺固化	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	吸杂	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	烧结/合金	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SiC 功率半导体	活化退火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
	热氧化	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	渗氮/氮化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	LPCVD (TEOS)	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	POA	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	接触退火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
MEMS	热氧化	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LPCVD	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VCSEL	热氧化	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	接触退火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	退火	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PV（光伏）	杂质扩散	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	热氧化	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
封装	聚酰亚胺固化	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	烘烤	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
FPD	固化 (聚酰亚胺固化)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	活化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	脱氢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	玻璃料烧制	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	金属接触退火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-